

## Fachprüfung

### **Elektronik II**

19. März 2025

Name:	Vorname:	
MatrNr.:	Fachrichtung:	

Α	B1	B2	B3	Gesamt
/32	/17	/11	/10	/70

Als Unterlagen für die Prüfung ist ein beidseitig handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt zugelassen. Alternativ kann auch ein einseitig bedrucktes DIN-A4-Blatt verwendet werden. Die Kombination aus einem teils handschriftlichen und teils bedruckten Blatt ist nicht zulässig und wird unmittelbar als Täuschungsversuch gewertet. In jedem Fall ist das DIN-A4-Blatt mit Name und Matrikelnummer zu versehen. Mobiltelefone sind nicht zugelassen.



### Teil A: Kurzfragen

Bitte markieren Sie alle richtigen Aussagen.

### Aufgabe A1

### 1.1 Logik Gatter (4 Punkte)

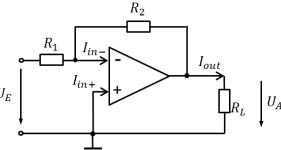
- □ Ein CMOS-Inverter erreicht im Gegensatz zum n-MOS Inverter einen minimalen logischen Ausgangspegel von 0 Volt.
- □ Ein NOR-Gatter in CMOS-Logik benötigt einen zusätzlichen Inverter am Ausgang, um die Logikpegel korrekt darzustellen.
- □ Die dynamische Verlustleistung eines CMOS-Gatters ist proportional zur Schaltfrequenz und der Lastkapazität.
- □ In Analogschaltungen werden MOS-Transistoren bevorzugt im Sättigungsbereich betrieben, um eine konstante Verstärkung sicherzustellen.

### 1.2. Invertierender Verstärker (4 Punkte)

- Die Spannung zwischen den Eingängen des Operationsverstärkers ist immer gleich der Betriebsspannung.
- □ Eine Erhöhung des Feedback-Widerstandes R2 vergrößert betragsmäßig die Verstärkung
- $\Box$  Der Eingangswiderstand der Schaltung entspricht dem Rückkopplungswiderstand  $R_2$ .
- □ Ein Kondensator parallel zum Rückkopplungswiderstand stabilisiert die Temperaturabhängigkeit des Verstärkers.

### 1.3 Bandbreite eines gegengekoppelten OPs (4 Punkte)

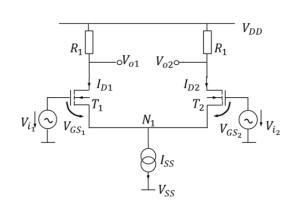
- □ Die Bandbreite eines gegengekoppelten Spannungsverstärkers ist die Frequenz, bei der die Verstärkung um 3 dB gegenüber ihrem maximalen Wert abgefallen ist.
- □ Die Stärke der Rückkopplung eines gegengekoppelten Verstärkers hat keinen Einfluss auf die Bandbreite.
- □ Das sog. Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (*gain-bandwidth product GBW*) ist die maximale Verstärkung geteilt durch die Bandbreite bei dieser Verstärkung.
- □ Die Amplitude und Phase steigen beide mit zunehmender Frequenz an





# 1.4 Großsignalverhalten der Differenzstufe (4 Punkte)

- □ Wenn ein Transistor sperrt und der Strom I<sub>ss</sub> komplett durch den anderen Transistor fließt, ist die obere Grenze für die Eingangsspannung erreicht
- Der Aussteuerbereich wird durch das W/L-Verhältnis der Transistoren eingestellt
- $\Box$  Der Aussteuerbereich ist durch den Strom  $I_{SS}$  einstellbar
- $\Box$  Ein kleiner Strom  $I_{SS}$  führt zu größerer Verlustleistung

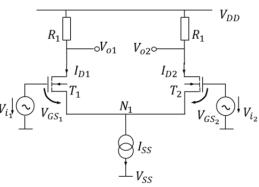


# 1.5 Kleinsignalverhalten von Transistoren (4 Punkte)

- Der Parameter  $g_m$ ist über das  $\frac{w}{L}$ -Verhältnis einstellbar.
- $\Box$  Der Widerstand  $r_{DS}$  modelliert den Substrateffekt im ESB
- $\Box$  Die Kanallängenmodulation führt zu einem kleineren  $u_{out}$  und reduziert somit die Verstärkung.
- $G \circ U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{GS}$   $U_{DS}$   $U_{DS}$   $U_{DS}$   $U_{DS}$   $U_{DS}$   $U_{SB}$   $U_{SB}$
- $\Box$  Die Stromquelle  $g_{mb} \cdot u_{SB}$  modelliert die Kanallängenmodulation, es gilt  $g_{mb} \gg 0$ .

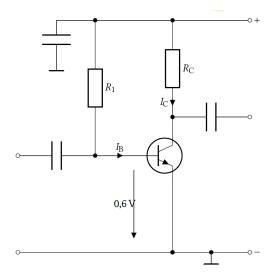
#### 1.6 Differenzstufe (4 Punkte)

- Schaltungstechnisch ist es sinnvoll die Bulk-Anschlüsse mit Source zu verbinden.
- ☐ Technologisch ist es vorteilhaft die Bulk-Anschlüsse mit Masse zu verbinden.
- Sowohl schaltungs- und technologietechnisch ist es sinnvoll die Bulk-Anschlüsse mit den jeweiligen Drain-Anschlüssen zu verbinden.
- □ Die Bulk-Anschlüsse müssen mit den jeweiligen Gate-Anschlüssen verbunden werden, da ansonsten die Transistoren immer sperren.



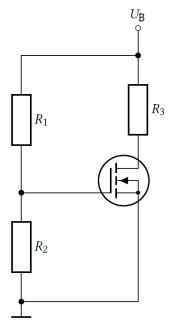
1.7 Die Betriebsspannung beträgt 5 V, der Kollektorstrom soll 4mA betragen, die Gleichstromverstärkung des Transistors beträgt 200. Berechnen Sie den Vorwiederstand R<sub>1</sub> (4 Punkte)

- $\Box$  ca.  $200k\Omega$
- □ ca. 715kΩ
- $\Box$  ca.  $68k\Omega$
- $\Box$  ca. 2,3k $\Omega$



1.8 Wie groß muss  $R_2$  gewählt werden, damit sich eine Spannung von 2,8V zwischen Gate und Source einstellt?  $U_B$ =44V,  $R_1$ =10k $\Omega$ ,  $R_3$ =2,2k $\Omega$  (4 Punkte)

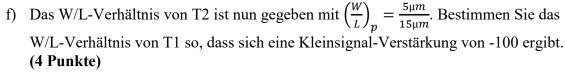
- $\Box$  ca.  $680\Omega$
- □ ca. 1405Ω
- $\Box$  ca.  $68\Omega$
- $\Box$  ca.  $820\Omega$

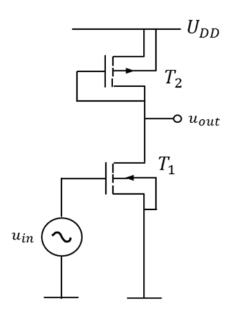


## Teil B: Aufgaben

Aufgabe B1 p-Kanal-Transistor als Lastelement

- a) Stellen Sie für die nebenstehende Schaltung das Kleinsignalersatzschaltbild (ESB) auf.(2 Punkte)
- b) Bestimmen Sie  $r_{out}$  unter der Annahme, dass gilt  $g_m \gg \frac{1}{r_{DS}}$ . (2 Punkte)
- c) Bestimmen Sie die Kleinsignal-Verstärkung *A.* (3 Punkte)
- d) Welchen Wert nimmt die Kleinsignal-Verstärkung an, wenn die beiden Transistoren T1 und T2 über ein identisches W/L-Verhältnis verfügen. Nehmen Sie hierbei an, dass gilt  $\beta_{0n} \approx 3\beta_{0p}$ . (4 Punkte)
- e) Wodurch ist die Annahme  $\beta_{0n} \approx 3\beta_{0p}$  zu begründen? (2 Punkte)





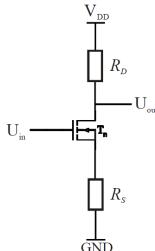
Name:	
ivallic.	



### Aufgabe B2 Analoge Schaltung

Geben sei folgende Schaltung:

$$V_{DD} = 5V$$
 $U_{Th0n} = 0.8V$ 
 $\beta_{0n} = \frac{100\mu A}{V^2}$ 
 $\lambda_n = 0.1V^{-1}$ 
 $R_S = 35k\Omega$ 
 $R_D = 100k\Omega$ 



- a) Dimensionieren Sie den Transistor so dass der Arbeitspunkt ( $U_{in}=2.5V,\,U_{out}=2.5V$ ) eingestellt wird.
  - Welche Spannung fällt über dem Widerstand  $R_S$  ab? (die Kanallängenmodulation  $\lambda$  kann bei dieser Dimensionierung vernachlässigt werden) (3 Punkte)
- b) Skizzieren Sie das Kleinsignal-ESB für die Schaltung. (Die Kapazitäten sind nicht zu berücksichtigen) (3 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Kleinsignalparameter des Transistors  $(g_m, g_{DS})$ . (2 Punkte)
- d) Berechnen Sie den Wert der Verstärkung der Schaltung. (3 Punkte)

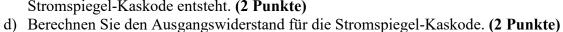
Name:



### Aufgabe B3

Stromspiegel mit Gegenkopplung

- a) Stellen Sie das
   Kleinsignalersatzschaltbild (ESB) für die nebenstehende Schaltung auf.
   (2 Punkte)
- b) Das Gatepotential  $U_{GG}$  des Transistor T1 kann als konstant angesehen und damit im ESB auf Masse gelegt werden. Ermittelten Sie den Ausgangswiderstand der Schaltung. (2 Punkte)
- c) Ersetzen Sie den Widerstand R in der nebenstehenden Schaltung so durch einen Transistor, dass eine Stromspiegel-Kaskode entsteht. (2 Punkte)



e) Bestimmen Sie die minimale Ausgangsspannung  $U_{out}$  der Stromspiegel-Kaskode. (2 Punkte)

